

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成19年5月31日(2007.5.31)

【公開番号】特開2001-294411(P2001-294411A)

【公開日】平成13年10月23日(2001.10.23)

【出願番号】特願2000-104926(P2000-104926)

【国際特許分類】

C 0 1 B	25/32	(2006.01)
A 6 1 L	27/00	(2006.01)
H 0 1 L	21/314	(2006.01)
H 0 1 L	21/822	(2006.01)
H 0 1 L	27/04	(2006.01)

【F I】

C 0 1 B	25/32	G
A 6 1 L	27/00	U
H 0 1 L	21/314	A
H 0 1 L	27/04	C

【手続補正書】

【提出日】平成19年4月5日(2007.4.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材上にアパタイト層が、積層した部分と、積層しない部分及び／又はそれらの組合せを含む微細構造体。

【請求項2】 前記のアパタイト層が、置換されていてもよいヒドロキシアパタイトである、請求項1記載の構造体。

【請求項3】 請求項1又は2記載の構造体を、それぞれ異なる又は同一のパターンで繰り返し形成させた微細積層構造体。

【請求項4】 (a) 基材の少なくとも1の面において、アパタイト層を形成させない領域を、被覆材で被覆する工程；

(b) アパタイト層を形成させる工程；並びに

(c) 被覆材を除去する工程

を含む、基材の表面に、所望のパターン又は微細構造体を有するアパタイト層を形成させる方法。

【請求項5】 前記(b)工程において、Caイオンが、0.02～25mmol·l<sup>-1</sup>、及びPイオン(P含有陰イオンとして含まれるリンの量)が、0.1～10mmol·l<sup>-1</sup>含まれ、pHが6～8である溶液を用いることを特徴とする、請求項4記載の方法。

【請求項6】 活性物質の存在下に、前記工程(b)を行うことを特徴とする、請求項4又は5記載の方法。

【請求項7】 前記の基材が、活性物質である、請求項4～6記載のいずれか1項記載の記載の方法。

【請求項8】 前記の被覆材が、ホトレジストである、請求項4～7のいずれか1項記載の方法。

【請求項9】 前記のアパタイト層が、置換されていてもよいヒドロキシアパタイトである、請求項4～8のいずれか1項記載の方法。

【請求項10】 請求項4～9のいずれか1項記載の方法によって微細構造体又はパターンを形成された電子素子。

【請求項11】 請求項4～9のいずれか1項記載の方法によって微細構造体又はパターンを形成された生体適合材。